



Высокая стойкость к
электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного применения

Низкочастотный Тиристор Тип Т283-2000-52

Средний прямой ток		I_{TAV}	2000 А	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии		U_{DRM}	4600 ÷ 5200 В	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение		U_{RRM}		
Время выключения		t_q	800 мкс	
U_{DRM} , U_{RRM} , В	4600	4800	5000	5200
Класс по напряжению	46	48	50	52
T_j , °C			-60 ÷ 125	

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{TAV}	Средний ток в открытом состоянии	А	2000 2322 2818	$T_c=93$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=85$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=70$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	А	3140	$T_c=93$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	кА	42.0 48.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=2$ А; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс
			45.0 52.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=2$ А; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс
I^2t	Защитный фактор	$A^2 \cdot 10^3$	8820 11520	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=2$ А; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс
			8400 11220	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=2$ А; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс

Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	B	4600÷5200	$T_j \min < T_j < T_j \max;$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	B	4700÷5300	$T_j \min < T_j < T_j \max;$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	B	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_j \max;$ управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	A	10	$T_j = T_j \max$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	B	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	5	$T_j = T_j \max$ для постоянного тока управления
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz)	A/мкс	800	$T_j = T_j \max; U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}; I_{TM} = 2 I_{TAV};$ Импульс управления: $I_G = 2$ A; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ A/мкс
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°C	-60÷125	
T_j	Температура р-п перехода	°C	-60÷125	
Механические параметры				
F	Монтажное усилие	кН	60.0 ÷ 70.0	
a	Ускорение	м/с ²	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Характеристики в проводящем состоянии				
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	B	2.50	$T_j = 25$ °C; $I_{TM} = 6300$ A
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	B	1.00	$T_j = T_j \max;$ $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	мОм	0.290	
I_L	Ток включения, макс	mA	1500	$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ B; Импульс управления: $I_G = 2$ A; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ A/мкс
I_H	Ток удержания, макс	mA	300	$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ B; управление разомкнуто
Блокирующие характеристики				
I_{DRM}, I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	mA	200	$T_j = T_j \max;$ $U_D = U_{DRM}; U_R = U_{RRM}$
$(dv_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, мин	B/мкс	1000	$T_j = T_j \max;$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; управление разомкнуто

Характеристики управления

U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	B	5.00 3.00 2.00	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 V; I_D = 3 A;$ Постоянный ток управления
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс	mA	500 300 200	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j \max}$	
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	B	0.35	$T_j = T_{j \max}$	$U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$ Постоянный ток управления
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	mA	15.00		

Динамические характеристики

t_{gd}	Время задержки включения	мкс	4.00	$T_j = 25^\circ C; V_D = 0.4 \cdot U_{DRM}; I_{TM} = 2000 A;$ Импульс управления: $I_G = 2 A$; $t_{GP} = 50 \text{ мкс}; di_G/dt \geq 1 A/\text{мкс}$
t_q	Время выключения, макс	мкс	800	$dv_D/dt = 50 \text{ В/мкс}; T_j = T_{j \max}; I_{TM} = 2000 A;$ $di_R/dt = -10 \text{ A/мкс}; V_R = 100 \text{ V};$ $V_D = 0.67 \cdot V_{DRM}$
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	8000	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = 2000 A;$ $di_R/dt = -5 \text{ A}/\mu\text{s};$ $V_R = 100 \text{ V}$
t_{rr}	Время обратного восстановления, макс	мкс	84	
I_{rrM}	Ток обратного восстановления, макс	A	190	

Тепловые характеристики

R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	0.0065	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R_{thjc-A}			0.0143		Охлаждение со стороны анода
R_{thjc-K}			0.0117		Охлаждение со стороны катода
R_{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	0.0015	Постоянный ток	

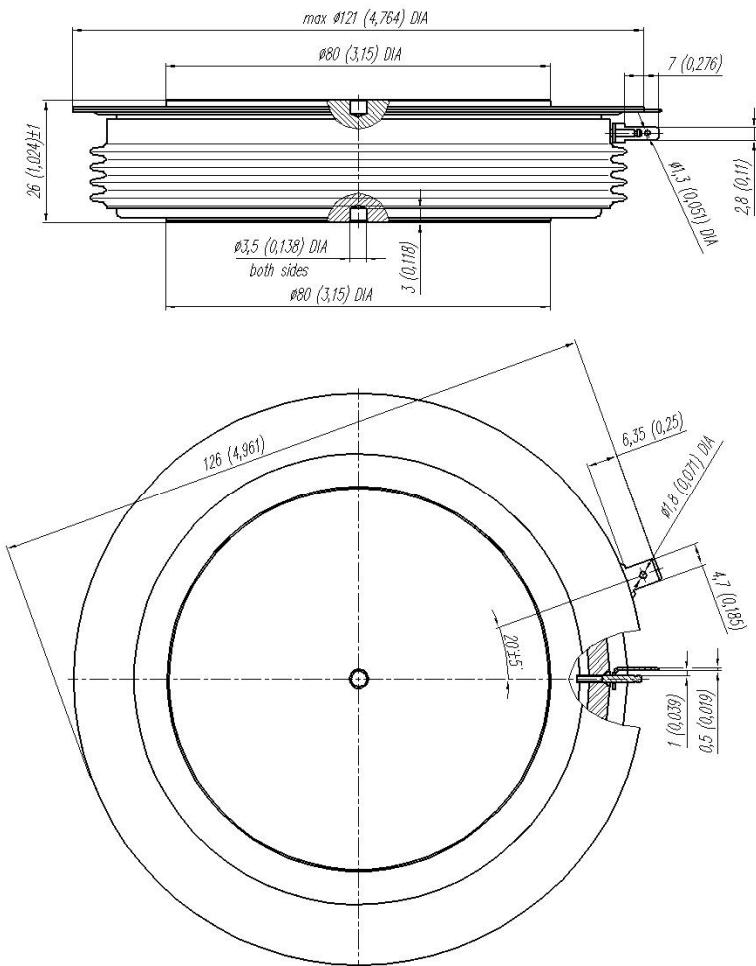
Механические характеристики

w	Масса, тип	г	1900	
D_s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	36.50 (1.437)	
D_a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	16.5 (0.650)	

МАРКИРОВКА

T	283	2000	52	УХЛ2
1	2	3	4	5

- Низкочастотный тиристор
- Конструктивное исполнение
- Средний ток в открытом состоянии, A
- Класс по напряжению
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т



Все размеры в миллиметрах (дюймах)

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав.
В интересах улучшения качества продукции, ЗАО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без
уведомления.

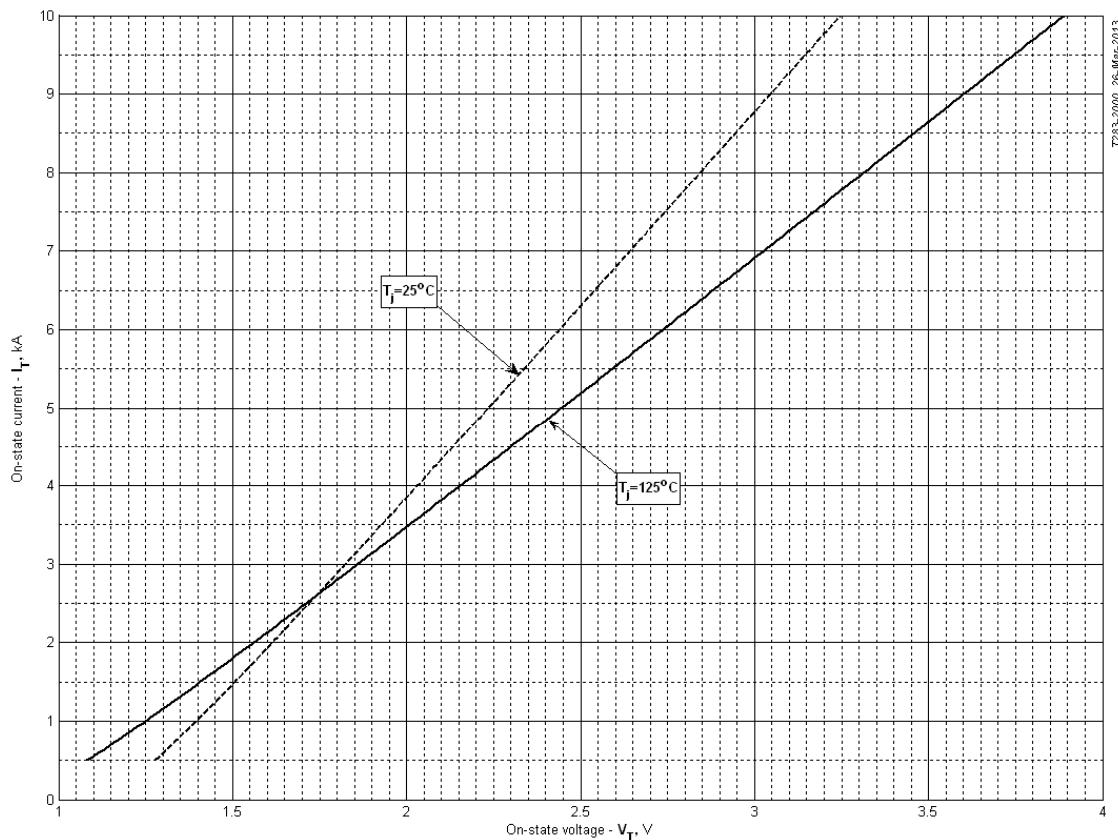


Fig 1 – On-state characteristics of Limit device

Analytical function for On-state characteristic:

$$V_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$$

	Coefficients for max curves	
	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$T_j = T_{j,\max}$
A	1.067403	0.793378
B	0.171446	0.247535
C	-0.163288	-0.218083
D	0.270001	0.360605

On-state characteristic model (see Fig. 1)

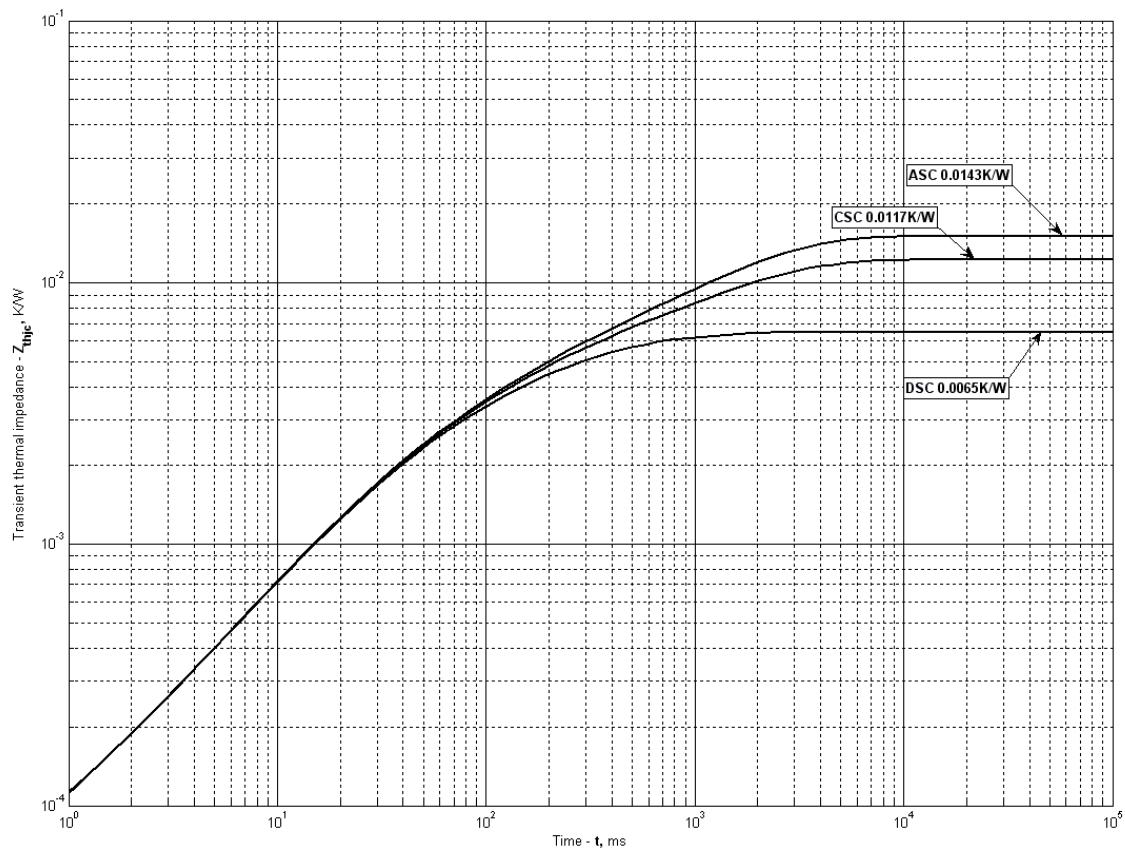


Fig 2 – Transient thermal impedance

Analytical function for Transient thermal impedance junction to case Z_{thjc} for DC:

$$Z_{thjc} = \sum_{i=1}^n R_i \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_i}} \right)$$

Where $i = 1$ to n , n is the number of terms in the series.

t = Duration of heating pulse in seconds.

Z_{thjc} = Thermal resistance at time t .

R_i = Amplitude of p_{th} term.

τ_i = Time constant of r_{th} term.

DC Double side cooled

i	1	2	3	4	5	6
R_i , K/W	0.001031	0.003117	0.001895	0.0004176	2.061e-005	1.999e-005
τ_i , s	0.7345	0.209	0.05291	0.01652	0.0006764	0.0002168

DC Cathode side cooled

i	1	2	3	4	5	6
R_i , K/W	0.001475	0.005797	0.002722	0.001822	0.0003923	3.824e-005
τ_i , s	0.8755	1.835	0.1997	0.05221	0.01594	0.0003499

DC Anode side cooled

i	1	2	3	4	5	6
R_i , K/W	0.00848	0.001792	0.002597	0.00179	0.0003904	3.851e-005
τ_i , s	1.845	0.9581	0.2011	0.05234	0.01605	0.0003606

Transient thermal impedance junction to case Z_{thjc} model (see Fig. 2)

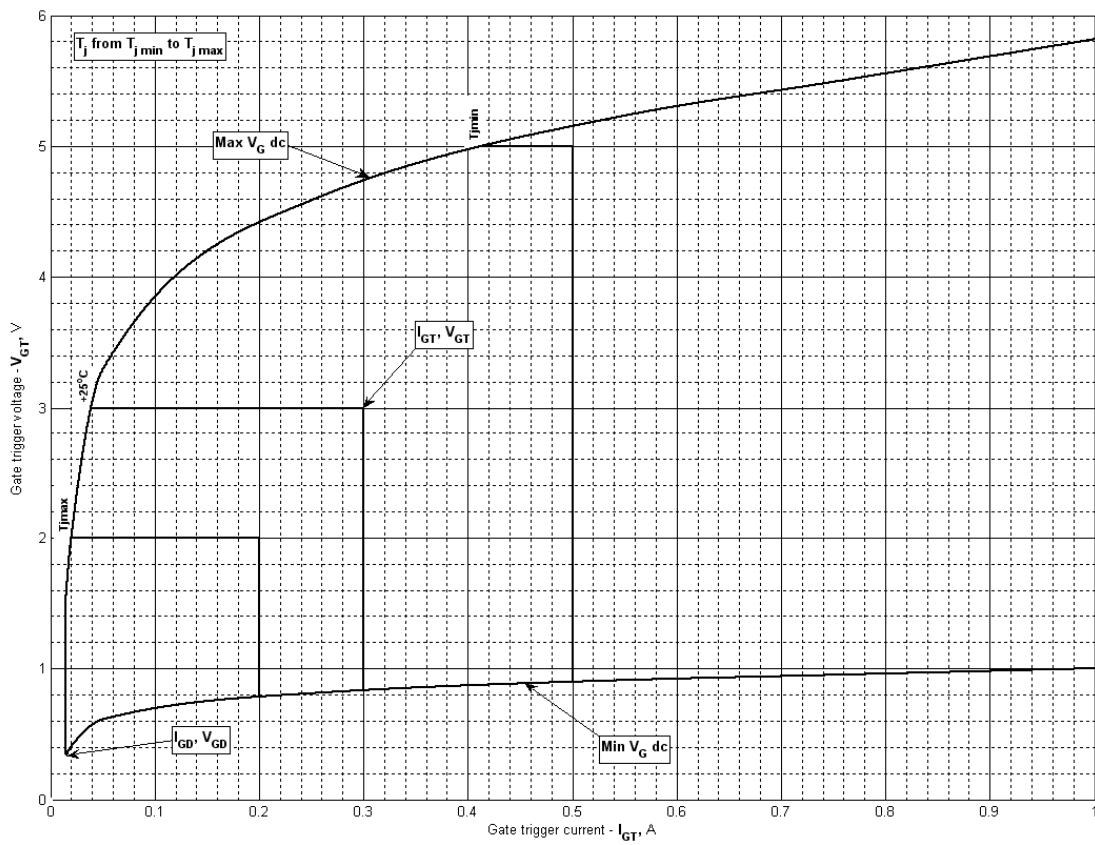


Fig 3 – Gate characteristics – Trigger limits

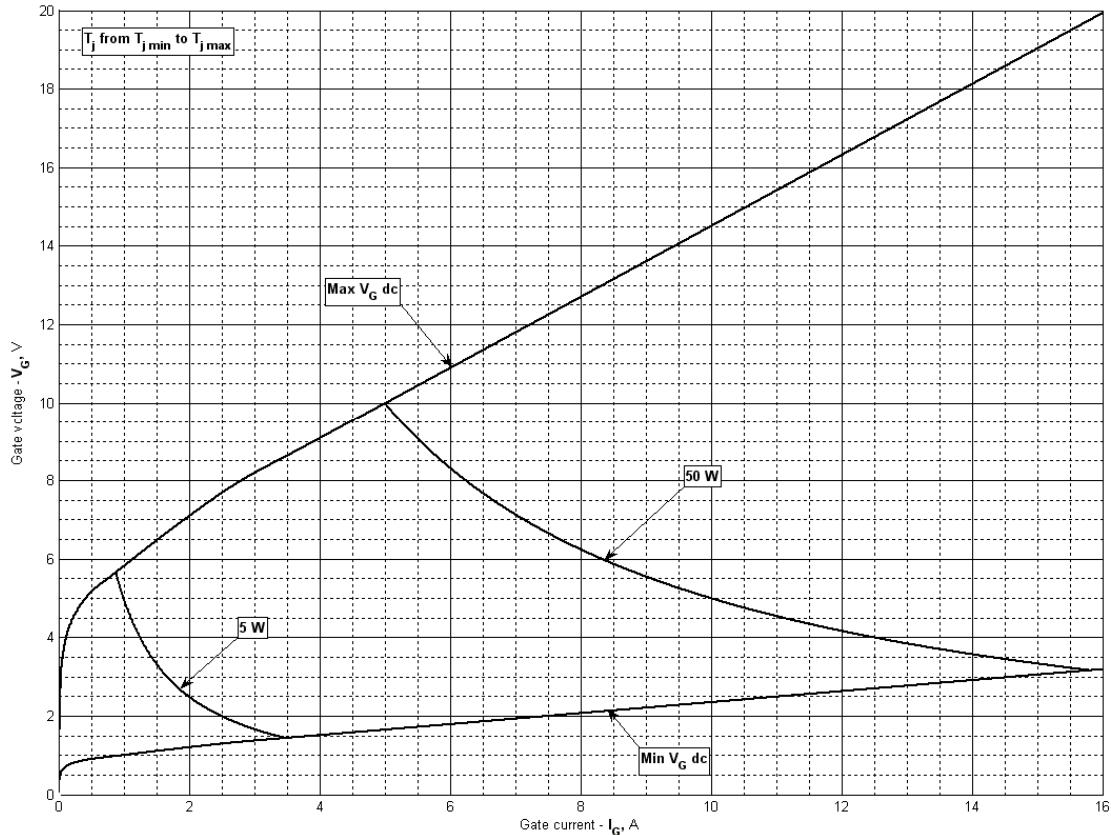


Fig 4 - Gate characteristics –Power curves

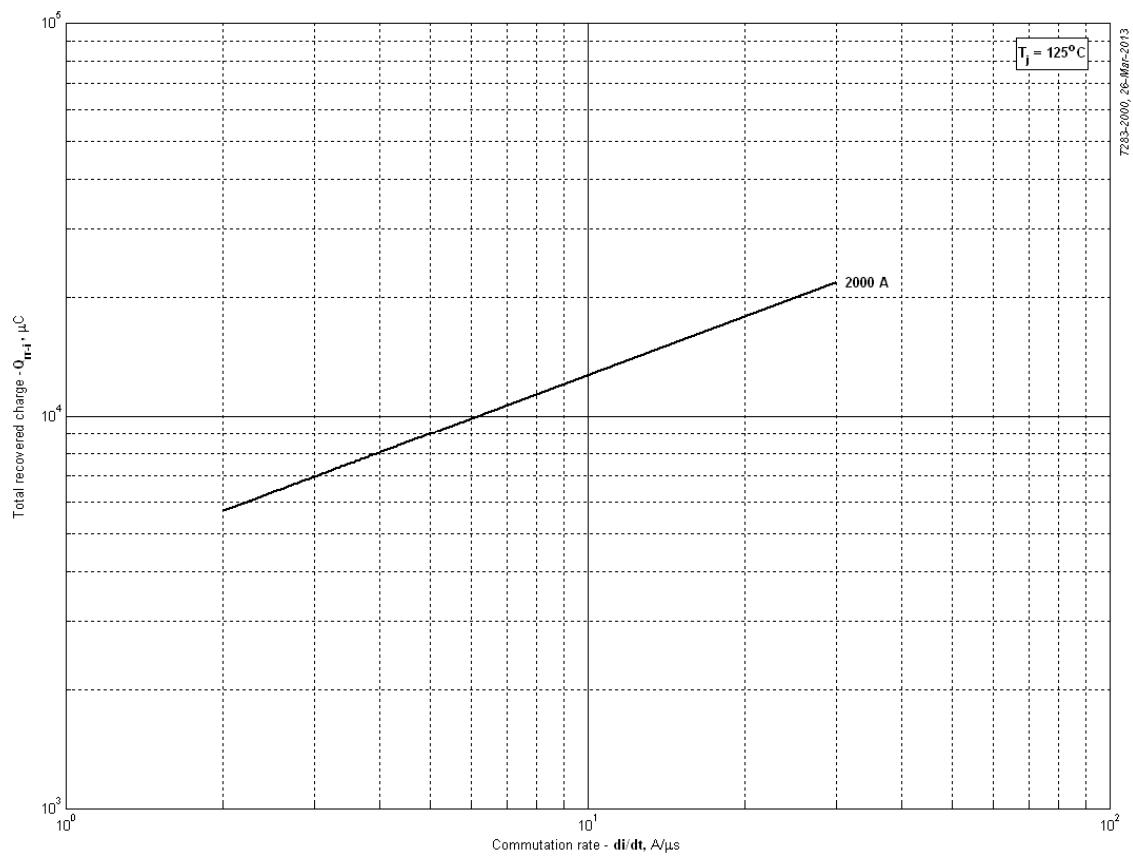


Fig 5 – Total recovered charge, Q_{rr-i} (integral)

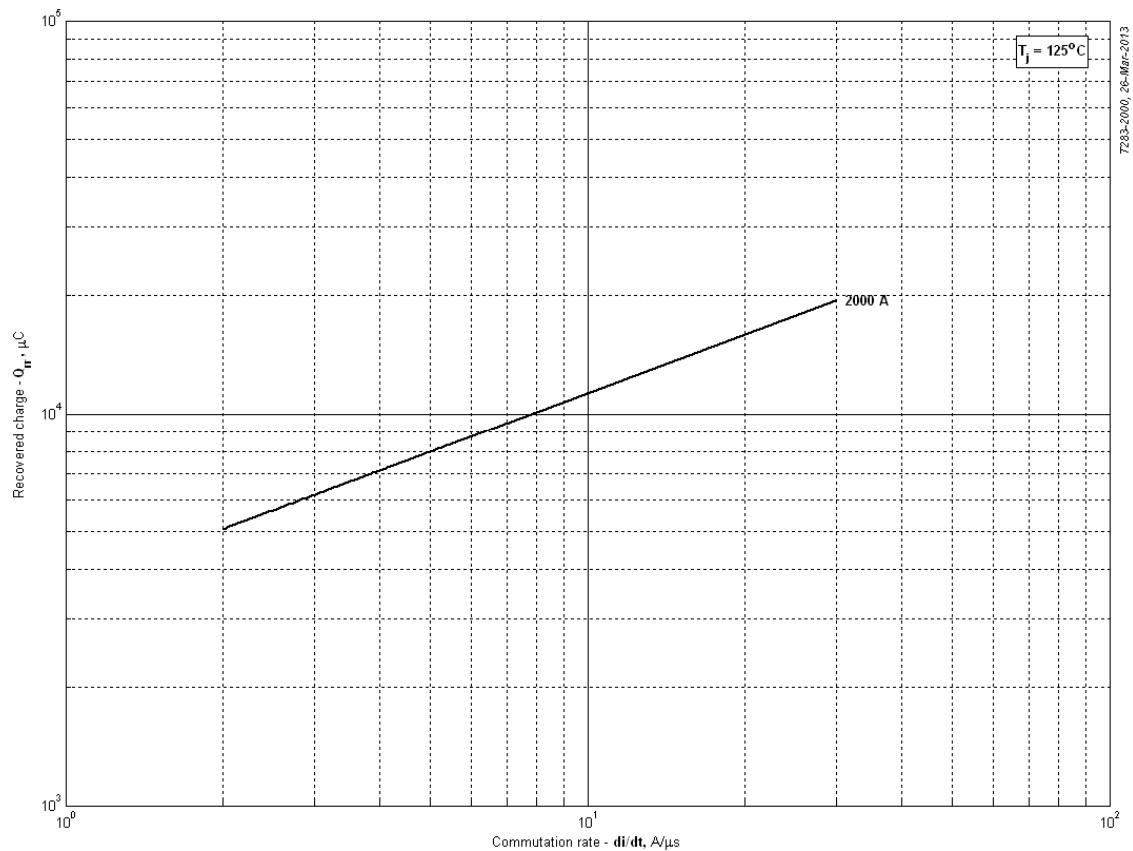


Fig 6 - Recovered charge, Q_{rr} (linear)

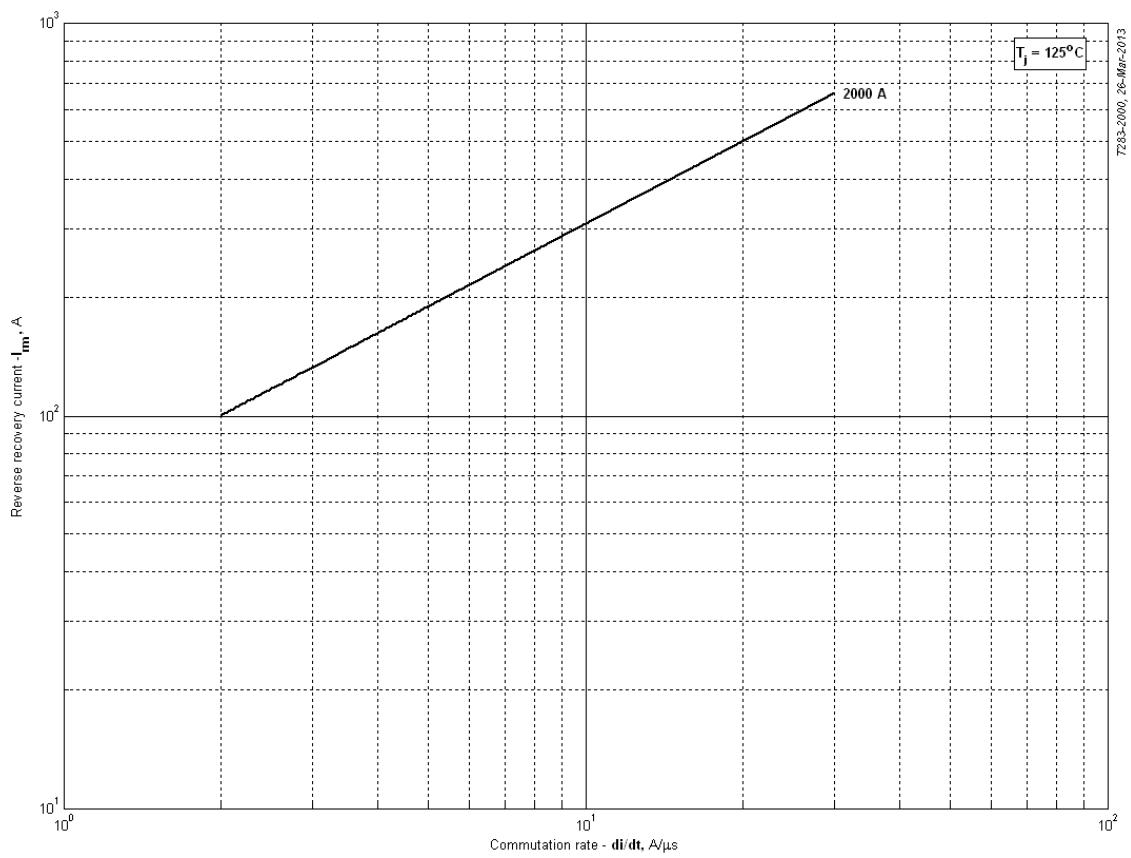


Fig 7 – Peak reverse recovery current, I_{rm}

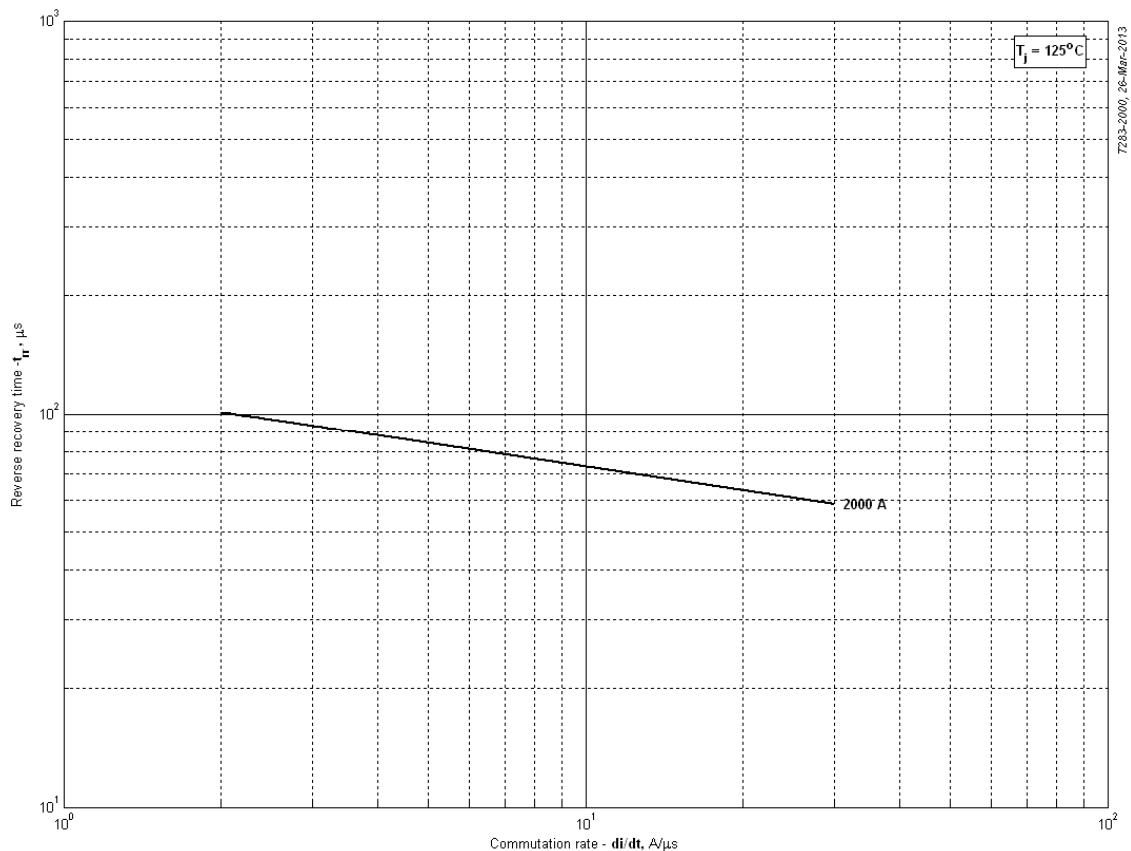


Fig 8 – Maximum recovery time, t_{rr} (linear)

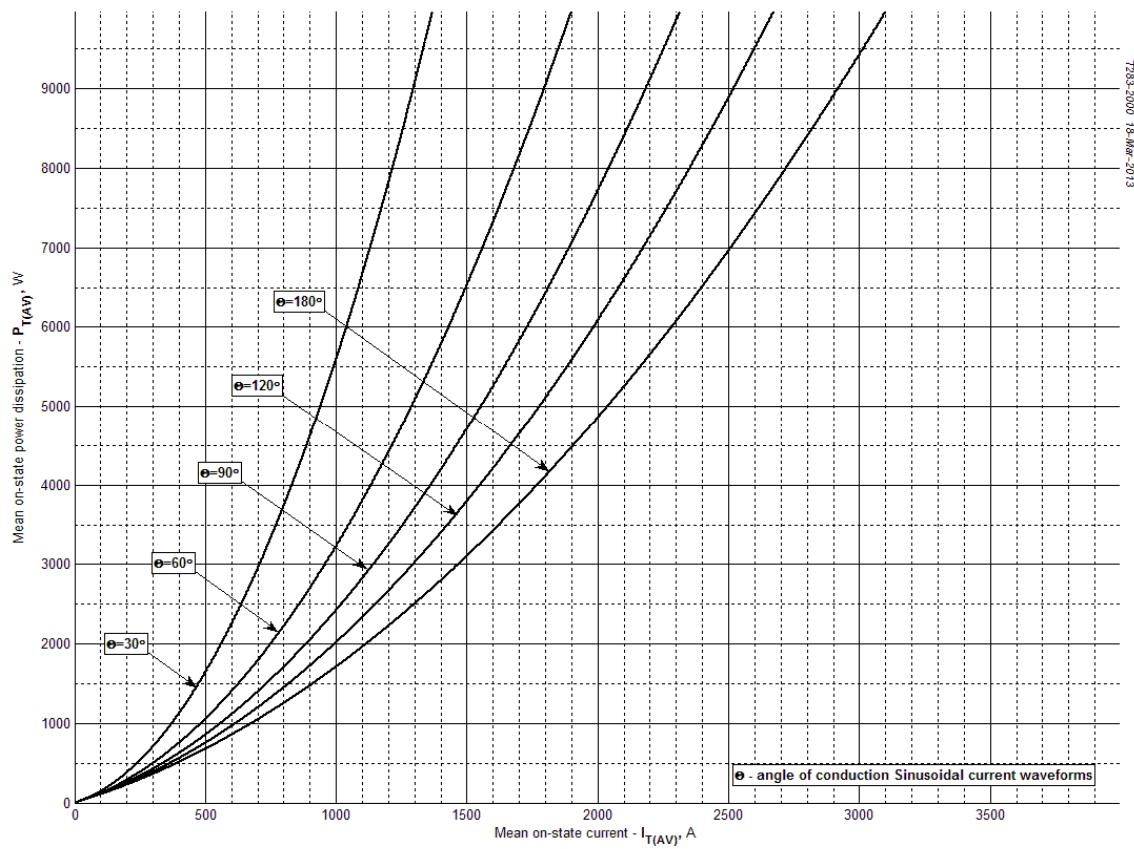


Fig 9 – On-state power loss (sinusoidal current waveforms)

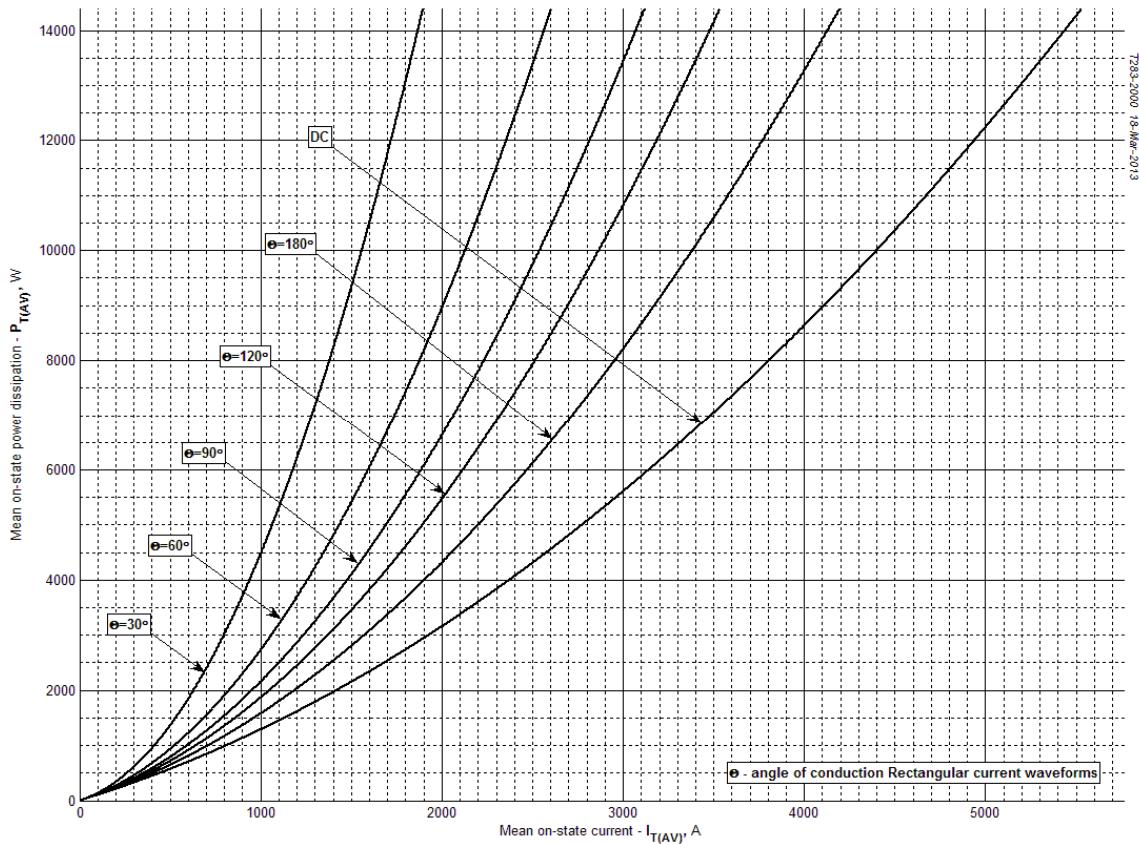


Fig 10 – On-state power loss (rectangular current waveforms)

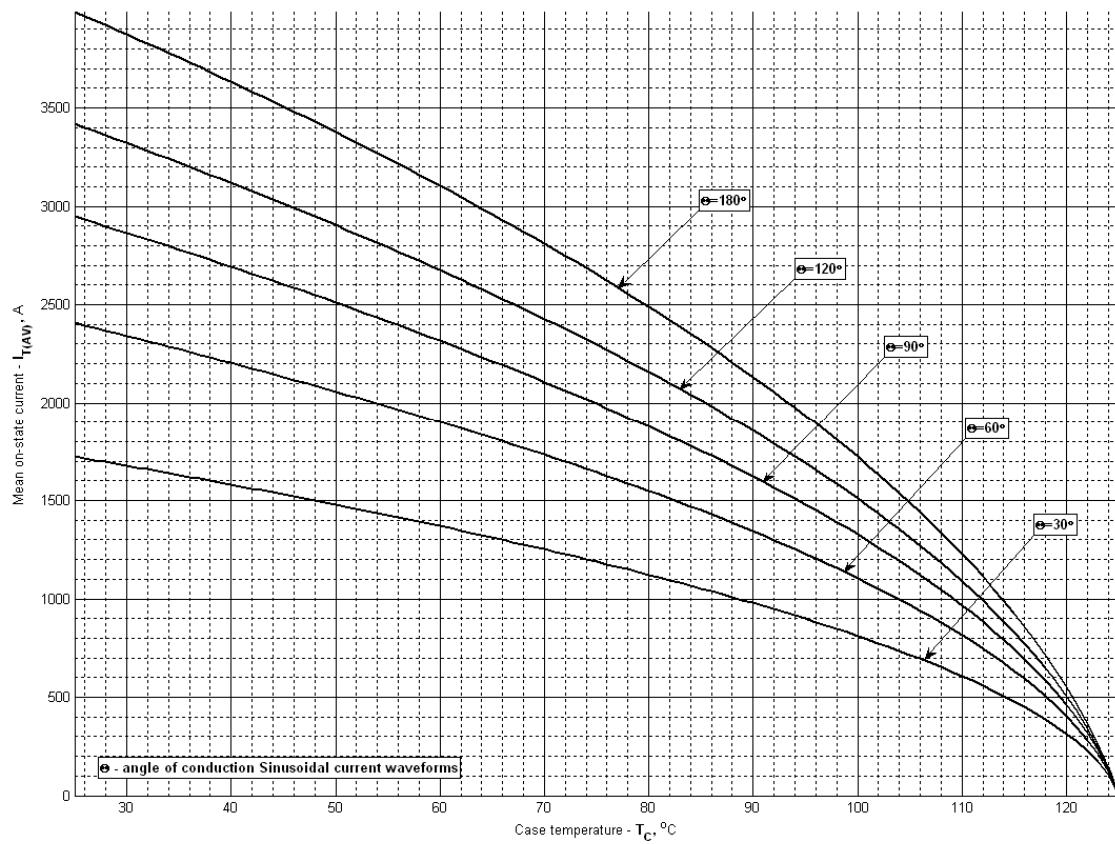


Fig 11 – Maximum case temperature DSC (sinusoidal current waveforms)

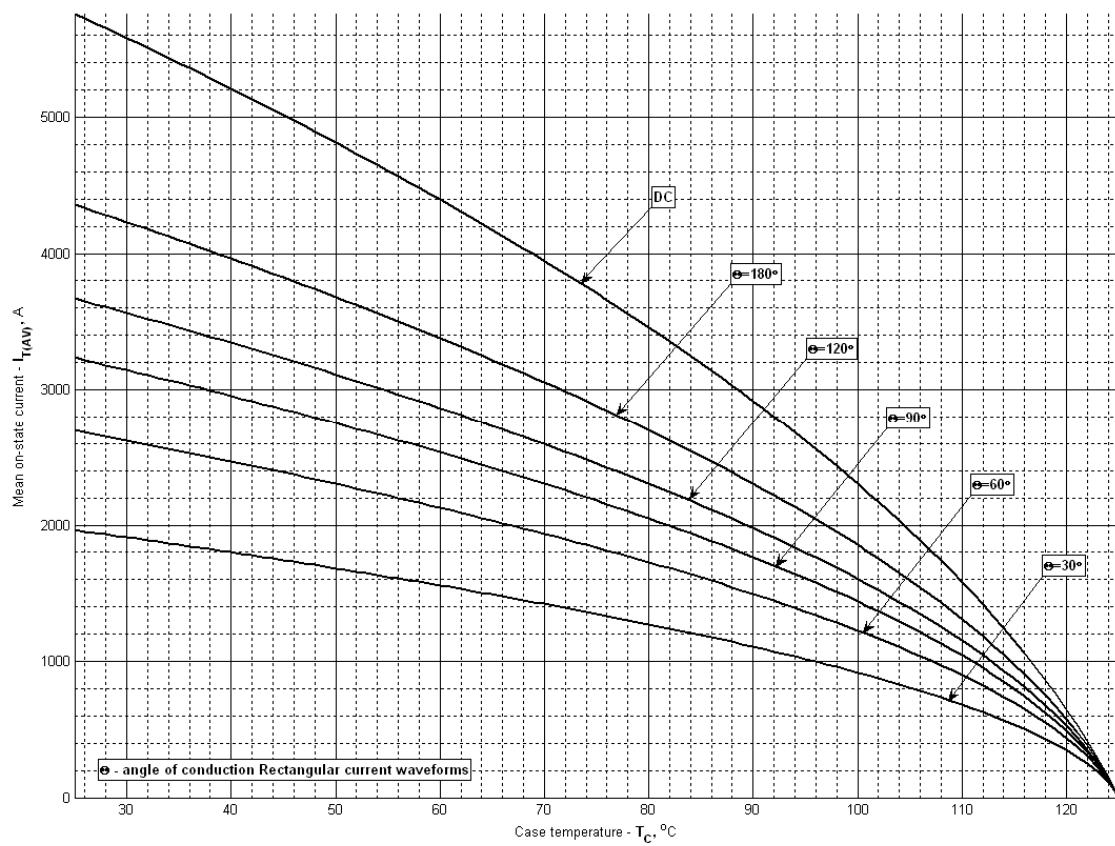


Fig 12 – Maximum case temperature DSC (rectangular current waveforms)

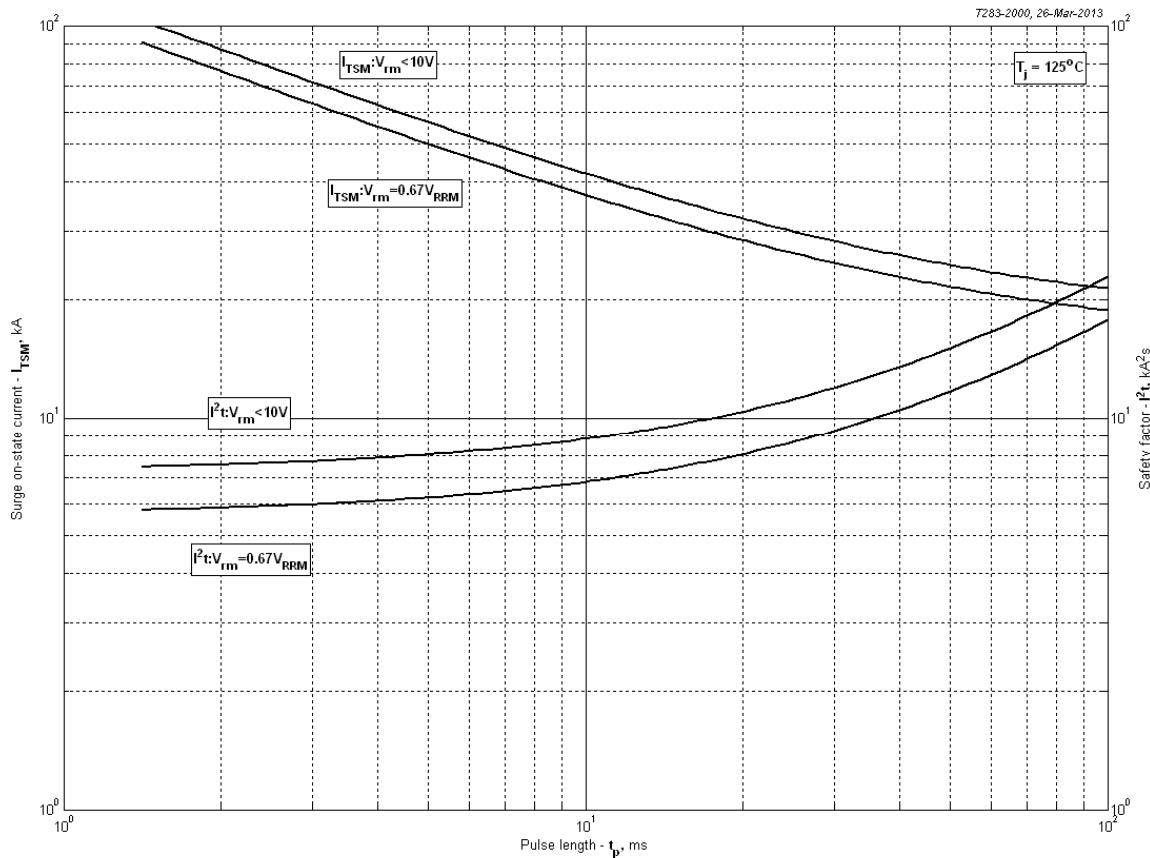


Fig 13 – Maximum surge and I^2t ratings

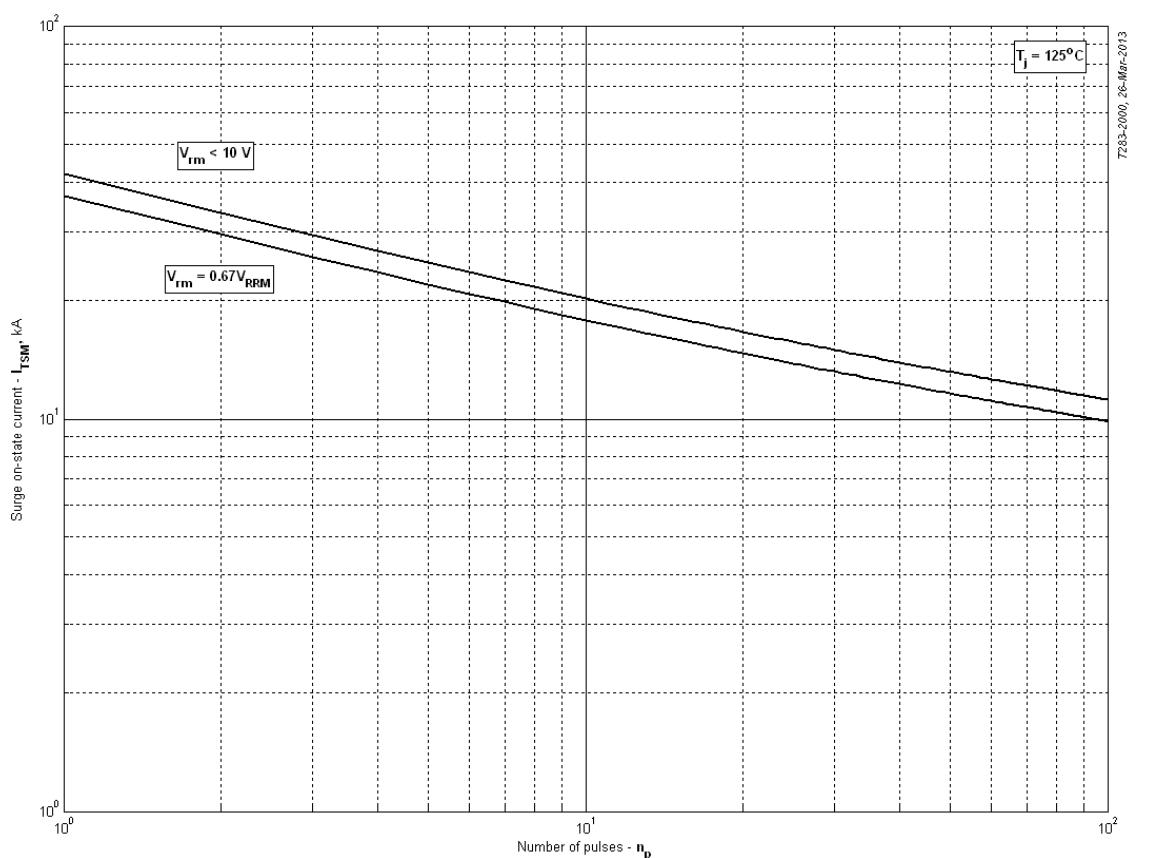


Fig 14 – Maximum surge ratings